

## 「第4回 窒化物半導体デバイスプロセス講習会」のご案内

窒化物半導体の応用・製品化にはデバイスプロセスの全過程を理解することが必要不可欠です。これまで、財団法人科学技術交流財団の支援の下、地域イノベーションクラスタープログラム（グローバル型）東海広域ナノテクものづくりクラスターの事業の一環として、窒化物半導体産業の技術開発の現状や応用など、より多くの窒化物半導体に応用に携わる企業や大学の技術者、研究者への情報交換を含めたシナジーの創出や人的交流を目的とした「窒化物半導体応用研究会」が平成20年より開催されてきました。この活動の中で、窒化物半導体デバイスプロセスの一連の流れを企業の技術者の皆様に学習していただく講習会を開催してきました。

これまでの実績を下に、地域イノベーションクラスタープログラム終了後も、豊橋技術科学大学の試作製造設備を使用して実習形式の講習会を行い、実際の現場で活かせるようになって頂きます。関心ある企業の皆様の多数のご応募をお待ち致しております。

### 記

【日 時】 平成25年9月9日（月）～10日（火）の2日間 午前9時～午後5時

【場 所】 国立大学法人 豊橋技術科学大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー  
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1

【内 容】 テーマ「Ga<sub>2</sub>N系発光ダイオードの製作と評価」  
- 各自のウエハで素子の作製と計測・評価を行う -

主な工程	概要説明
	素子分離（ホトリソ、ICP-RIE）
	n型電極（ホトリソ、蒸着、リフトオフ、シンタ）
	p型電極（ホトリソ、蒸着、リフトオフ、シンタ）
	SiO <sub>2</sub> 保護膜形成（プラズマCVD）
	コンタクトホール形成（ホトリソ、エッチング）
	特性チェック（I-V、L-I、スペクトル）

【参加費】 10万円（税込み）/名 \*材料費、着衣貸出し等の費用を含みます。

【定 員】 10名程度（未経験者でもご参加頂けます。）

\*申込者多数の場合には、選考の上、決定いたします。

【申込方法】詳細が決まり次第、お知らせさせていただきますので、メールなど連絡先を下記メールアドレスご連絡下さい。

nitrideprocess@int.ee.tut.ac.jp



主催： 豊橋技術科学大学・ベンチャービジネスラボラトリー（VBL）

共催： (株)豊橋キャンパス・イノベーション（とよはしTLO）

後援： 科学技術交流財団、